

概述

XS2123 是一款基于 IEEE 802.3af 标准 PD 和 DC/DC 集成的控制器。

该芯片的 PD 控制器部分为用电设备 (PD) 提供符合以太网供电 (PoE) 系统的检测信号、分级信号以及带有浪涌电流控制的集成隔离功率 MOSFET。集成隔离功率 MOSFET 耐压 100V，导通阻抗 0.4Ω，支持最大 880mA 的工作电流，内置欠压保护和过热保护。带有较宽的迟滞和长周期干扰脉冲屏蔽，以补偿双绞线电缆的阻性衰减，确保上电/掉电期间无干扰传输。

该芯片的 DC/DC 控制器部分内置 200V 功率 MOSFET，采用原边控制 (PSR) 方式，适用于 Flyback 拓扑结构，支持 CCM，DCM，提供精确的恒压控制模式，采用 PWM+PFM 模式的多段曲线控制运行模式可以进一步优化系统在不同负载下的转换效率，同时有效避免了噪声。

典型应用

- ◆ 网络摄像机
- ◆ IP 电话
- ◆ 无线 AP

订购信息

PART	TEMP RANGE	PIN-PACKAGE
XS2123	-40°C~+105°C	SOP16L

主要特点

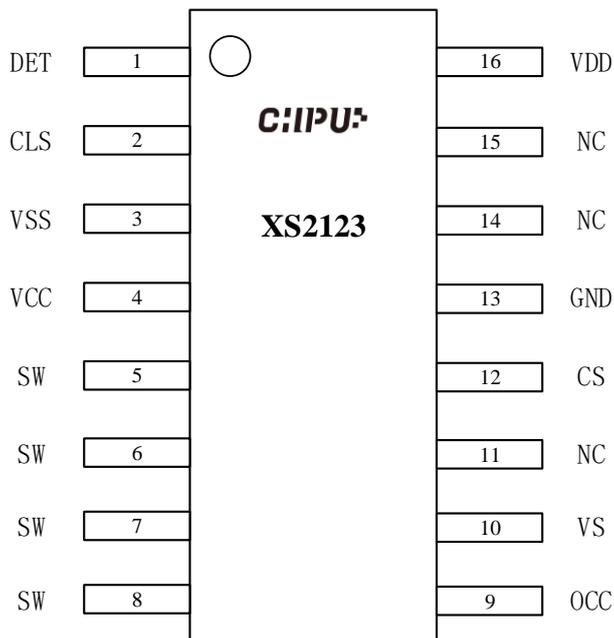
PD 控制器部分

- ◆ 兼容 IEEE 802.3af 受电设备的完整电源接口
- ◆ 集成 100V，0.4Ω 的隔离功率 MOSFET
- ◆ 欠压保护
- ◆ 过热保护
- ◆ MOSFET 耐受 880mA 电流
- ◆ 180mA 最大浪涌电流限流
- ◆ 电流限制和折返式保护
- ◆ 正常工作期间电流限制在 760mA 至 1000mA

DC/DC 控制器部分

- ◆ 支持 CCM&DCM 的原边控制模式
- ◆ 内置 200V 高压 MOSFET 开关
- ◆ 最高 12W 输出功率
- ◆ 较低启动电流 (大约 7uA)
- ◆ 轻载降频，降低能耗
- ◆ 内置有源周期谐振技术
- ◆ 输出短路保护及输出过流保护
- ◆ 输出过压保护及 VCC 过压保护
- ◆ 软启动
- ◆ 峰值电流控制模式
- ◆ 内置 LEB 前沿消隐

引脚说明



浙江芯昇电子技术有限公司
 地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1168 号
 网址：www.chipup.com
 邮编：310053

感谢您使用本公司的产品，建议您在使用前请仔细阅读本资料。
 本公司产品在不断更新和改进，希望您与本公司保持联系，索取最新资料。
 本资料中的信息如有变化，恕不另行通知。
 本资料仅供参考，本公司不承担任何由此而引起的损失。
 本公司不承担任何在使用过程中引起的侵犯第三方专利或其它权利的责任。